

# **Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)**

International application number: PCT/JP05/005408

International filing date: 24 March 2005 (24.03.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP  
Number: 2004-096008  
Filing date: 29 March 2004 (29.03.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 12 May 2005 (12.05.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland  
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

日本国特許庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application: 2004年 3月29日

出願番号 Application Number: 特願2004-096008

パリ条約による外国への出願に用いる優先権の主張の基礎となる出願の国コードと出願番号

The country code and number of your priority application, to be used for filing abroad under the Paris Convention, is

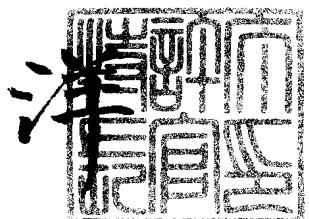
出願人 Applicant(s): 住友電気工業株式会社

J P 2004-096008

2005年 4月20日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

小川



【書類名】 特許願  
【整理番号】 10410132  
【提出日】 平成16年 3月 29日  
【あて先】 特許庁長官殿  
【国際特許分類】 H01L 29/24  
【発明者】  
　【住所又は居所】 兵庫県伊丹市昆陽北一丁目1番1号 住友電気工業株式会社伊丹  
　【氏名】 製作所内  
　　西林 良樹  
【発明者】  
　【住所又は居所】 兵庫県伊丹市昆陽北一丁目1番1号 住友電気工業株式会社伊丹  
　【氏名】 製作所内  
　　宮崎 富仁  
【発明者】  
　【住所又は居所】 兵庫県伊丹市昆陽北一丁目1番1号 住友電気工業株式会社伊丹  
　【氏名】 製作所内  
　　今井 貴浩  
【特許出願人】  
　【識別番号】 000002130  
　【氏名又は名称】 住友電気工業株式会社  
【代理人】  
　【識別番号】 100088155  
　【弁理士】  
　【氏名又は名称】 長谷川 芳樹  
【選任した代理人】  
　【識別番号】 100089978  
　【弁理士】  
　【氏名又は名称】 塩田 辰也  
【選任した代理人】  
　【識別番号】 100092657  
　【弁理士】  
　【氏名又は名称】 寺崎 史朗  
【選任した代理人】  
　【識別番号】 100110582  
　【弁理士】  
　【氏名又は名称】 柴田 昌聰  
【手数料の表示】  
　【予納台帳番号】 014708  
　【納付金額】 21,000円  
【提出物件の目録】  
　【物件名】 特許請求の範囲 1  
　【物件名】 明細書 1  
　【物件名】 図面 1  
　【物件名】 要約書 1  
　【包括委任状番号】 0308433

**【書類名】特許請求の範囲**

**【請求項 1】**

炭素系材料基板上にレジストを塗布する工程と、

当該塗布したレジストに所定の配置規則に従って穴を開け、その穴の壁は開口部から奥側に向かって逆テーパーになるように加工する工程と、

前記開口部側からマスク材料を蒸着し、前記穴の内部にマスク蒸着物を形成する工程と、

前記レジスト上に蒸着されたマスク材料を前記レジストと共にリフトオフする工程と、

前記マスク蒸着物をマスクとして前記炭素系材料基板をエッチングし、炭素系材料突起を形成する工程と、

を含む炭素系材料突起の形成方法。

**【請求項 2】**

前記炭素系材料突起は、所定の配置規則に従って複数個形成されており、その個々の投影径は 300 nm 以下であり、その存在する密度は 4 個/ $\mu m^2$  以上であることを特徴とする請求項 1 に記載の炭素系材料突起の形成方法。

**【請求項 3】**

前記炭素系材料突起は円錐状であることを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の炭素系材料突起の形成方法。

**【請求項 4】**

先端径が 100 nm 以下であり、突起密度が 4 個/ $\mu m^2$  以上であり、所定の配置規則に従って並んでいる炭素系材料突起であって、該突起先端は突起根元に比べて細くなっていることを特徴とする炭素系材料突起。

【書類名】明細書

【発明の名称】炭素系材料突起の形成方法及び炭素系材料突起

【技術分野】

【0001】

本発明は、炭素系材料突起の形成方法及び炭素系材料突起に関する。

【背景技術】

【0002】

これまで、ダイヤモンドの突起構造を形成する場合、Siの異方性エッティングの窪んだ型にダイヤモンドを形成して、Siを除去し、多結晶ダイヤモンドのピラミッドを形成する方法があった（例えば、下記非特許文献1参照）。しかし、この方法を電子放出素子に利用する場合、先端粒径を小さくする必要から突起は多結晶となり、突起内部に粒界が存在するために、電子の輸送がスムースでなく、NEA表面から効率よく電子の放出ができる問題点があった。また、近接場光プローブを利用する場合にも、多結晶であれば粒界や個々の結晶のひずみによる光の散乱で、光の伝播がスムースでないという問題もあった。また、突起の角度があまり鋭くない（70度程度）という欠点もあった。

【0003】

そこで、単結晶を用いたピラミッドを形成する方法や種々の形状の突起を形成する方法が開発された（例えば、下記非特許文献2参照）。その方法はダイヤモンドの表面に微小な円柱を形成し、その円柱上に成長バラメーターを制御しながら、ダイヤモンドをエピタキシャル成長して、先端が尖ったピラミッド状の突起を作るというものである。また、その微小円柱突起をさらにエッティングして、尖鋭化する方法も報告されている。さらに、Alマスクを使って2段階のローソク型の突起を形成する方法も報告されている（例えば、下記非特許文献3、非特許文献4参照）。

【0004】

また、ダイヤモンドを加工して突起を形成する先行文献（非特許文献5）もある。この中で、ローソク型の突起はアスペクト比が高く、しかも非常に高密度で、先端も非常に鋭角に尖った突起を形成するのに有力な形状である。しかしながら、これらの突起一つはせいぜい1μm角のものであり、同じ方法で、それ以上に小さいものを形成することは困難で、実際に形成しても精度よく同じものは形成できなかった。すなわち、一つの突起は単結晶で、突起が整列しており、突起が10%以内で非常に均一で、先端が鋭角（45度以下）で、アスペクト比が高く、突起以外の基板面は平坦で、1μm角に4個以上の突起を形成することなどは満たすことには全く適用できなかった。

【非特許文献1】K. Okano, K. Hoshina, S. Koizumi and K. Nishimura, "Diamond and Related Materials 5" (1996) 19-24

【非特許文献2】Y. Nishibayashi, H. Saito, T. Imai and N. Fujimori, "Diamond and Related Materials 9" (2000) 290-294

【非特許文献3】西林良樹、安藤豊、古田寛、小橋宏司、目黒貴一、今井貴浩、平尾孝、尾浦憲治郎、「SEIテクニカルレビュー（2002年8月号）」

【非特許文献4】Yoshiki Y. Nishibayashi, Yutaka Ando, Hiroshi Furuta, Natsuo Tatsumi, Akihiko Namba and T. Imai, "Sumitomo Electric Industries Technical Review, No. 57" (2004) 33-36

【非特許文献5】E. S. Baik, Y. J. Baik and D. Jeon, "Thin Solid Films 377-378" (2000) 299-302

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

## 【0005】

ローソク型突起を形成するためにA1を用いることはすでに開示されているが、以上の課題を達成するための精度はまったく良くなかった。他の材料をマスクに用いると、非特許文献5に示すように鋭角な先端を形成することも困難となる。微小な先端径の精度を上げるために精度の良い微小さなマスクを必要とするが、300nm以下の径の配列したマスクについてはこれまで前例がなく、50nm以下の配列したマスクについては全く未知であった。さらに、突起が10%以内で均一で、1μm角に4個以上の突起を形成することを満たす方法についても不明であった。

## 【0006】

そこで本発明では、ダイヤモンド基板上に形成された突起先端は微小で、突起先端が鋭角となり、アスペクト比が高く、突起以外の基板面は平坦となるための微小さな精度良い微細マスクを形成できる、炭素系材料突起の形成方法及び炭素系材料突起を提供することを目的とする。

## 【課題を解決するための手段】

### 【0007】

前述の課題に鑑み本発明者らは、非常に微細な鋭角な突起を得るためのダイヤモンド用のマスクとして円錐状微細マスクを用いることを見出した。本発明はこの知見に基づいてなされたものである。

### 【0008】

本発明の炭素系材料突起の形成方法は、(1)炭素系材料基板上にレジストを塗布する工程と、(2)当該塗布したレジストに所定の配置規則に従って穴を開け、その穴の壁は開口部から奥側に向かって逆テーパーになるように加工する工程と、(3)開口部側からマスク材料を蒸着し、穴の内部にマスク蒸着物を形成する工程と、(4)レジスト上に蒸着されたマスク材料をレジストと共にリフトオフする工程と、(5)マスク蒸着物をマスクとして炭素系材料基板をエッチングし、炭素系材料突起を形成する工程と、を含む。

### 【0009】

本発明の炭素系材料突起の形成方法によれば、開口部から奥側に向かって逆テーパーになるように形成されている穴の開口部側からマスク材料を蒸着するので、突起先端が鋭角でアスペクト比が高いマスク蒸着物を規則正しく形成できる。

### 【0010】

また本発明の炭素系材料突起の形成方法では、炭素系材料突起が、所定の配置規則に従って複数個形成されており、その個々の投影径は300nm以下であり、その存在する密度は4個/μm<sup>2</sup>以上であることも好ましい。

### 【0011】

また本発明の炭素系材料突起の形成方法では、炭素系材料突起は円錐状であることも好ましい。

### 【0012】

本発明の炭素系材料突起は、先端径が100nm以下であり、突起密度が4個/μm<sup>2</sup>以上であり、所定の配置規則に従って並んでいる炭素系材料突起であって、該突起先端は突起根元に比べて細くなっている。

## 【発明の効果】

### 【0013】

本発明の炭素系材料突起は若干の先端径を犠牲にすれば、非常に高さ均一性が良いことが作製原理上から理解できる。また、尖る中心は突起の中心軸からぶれていないので、デバイスを作製する場合も再現性がよい。さらに微小サイズであるので、高密度にエミッタを並べることができ、電流密度をこれまで以上に大きくできる。突起のアスペクト比を大きくすることと高密度にすることが同時にできる。先端の中心軸の精度、高さバラツキが極めて小さいなどの特徴があり、電子放出特性に大きく効果を発揮する。このような均一な突起は電子放出素子、原子プローブ、近接場光プローブにおいて特に重要な部品となり得る。このような電子放出素子は、電子銃、電子管、真空管、フィールド・エミッション

・ディスプレイ(FED)などに応用可能である。また、このような原子プローブや近接場光プローブは、STM、AFM、SNOM等やこれらの原理を用いた電子機器に応用可能である。

### 【発明を実施するための最良の形態】

#### 【0014】

本発明の知見は、例示のみのために示された添付図面を参照して以下の詳細な記述を考慮することによって容易に理解することができる。引き続いて、添付図面を参照しながら本発明の実施の形態を説明する。可能な場合には、同一の部分には同一の符号を付して、重複する説明を省略する。

#### 【0015】

本実施形態の炭素系材料突起の形成方法について説明する。まず、図1(a)に示すように、ダイヤモンド基板10上にレジスト11(フォトレジストあるいは電子線用レジスト)を塗布し、側壁12bが開口部12a側からみて若干逆テーバー型になるようにレジストに微細な穴12を開けた。電子線用レジストの場合、ポジ型のレジストで逆テーバーの側壁は実現しやすいので、より有効である。

#### 【0016】

その後、図1(b)に示すように、蒸着により金属13(マスク材料)をレジスト膜厚よりも少なめに形成する。この場合、穴12が埋まるまで蒸着すると穴12の内部にできた蒸着物14(マスク蒸着物)はほぼ円錐状の突起となる(図1(b)の下段参照)。穴12が埋まるまでに蒸着をやめてもよく、その場合は蒸着物14は円錐台となる(図1(b)の上段参照)。その後、レジスト剥離液などで、レジスト11を剥離、除去して、規則正しく配列した突起のマスクとなる。マスク材料は剥離液などでエッチングされない材質が好ましい。

#### 【0017】

その後、円錐あるいは円錐台の蒸着物をマスクとして(図2(a)参照)、ダイヤモンドをエッチングする。その結果、ダイヤモンドの円錐の微小な突起(炭素系材料突起)を形成できる(図2(b)参照)。マスクの形状が円錐あるいは円錐台であることが重要であり、その形状に転写して、ダイヤモンドの円錐突起などが形成される。また、マスク材料とダイヤモンドのエッチング選択比が大きいことが好ましい。それは突起の背が高くなり、鋭角な突起を形成することができるからである。

#### 【0018】

例えは、マスク材料としてAu、Mo、Wなどが利用できる。ただし、ダイヤモンドのエッチングは酸素を含むガスである必要がある。ArやN<sub>2</sub>を多く含むガス(10%以上)はあまり好ましくない。それはマスク材料が早く小さくなり、選択比が大きくならず、突起の角度も45度以下の小さい値が得られないからである。

#### 【0019】

また、リフトオフを行うレジストはダイヤモンドの上に直接形成することもできるが、その間に下敷きのための金属などを形成してもよい。それはダイヤモンドの導電性が低くて、チャージアップの恐れがある場合に、利用すると効果がある。微細加工精度向上にはチャージアップしないことは重要である。また、マスクとなる突起材料とダイヤモンドの密着性を向上する場合も効果がある。しかしながら、突起を形成後、下敷きのための金属を除去することが必要である。

#### 【0020】

従って、マスク材料が除去されず、下敷き材料が除去される条件があることが必要となってくる。マスク材料がAuで下敷き材料がTiやMoという選択などはこの条件を満たす。マスク材料はAuやPtのように薬品耐久性のある材料は有効である。マスク材料はリフトオフで形成されるので、基本的にどのような材料でも作製できる。

#### 【0021】

ここで、具体的にマスク材料を例示しながら、本突起マスクの形成方法を説明する。図1(a)に示しているように、まず、ダイヤモンド基板10上にレジスト11を塗布し、

電子線露光によってテーパー付き穴12を開ける。そこに、AuあるいはMoを金属13蒸着し、次第に先端が細くなる形状を形成する（図1（b）参照）。この突起を形成する方法については基本的には既に周知の技術であるが、非常に微細に（300nm以下に）形成することはこれまでになされていなかった。

#### 【0022】

それをダイヤモンドなどのエッティングのマスクとすることも検討された例はなかった。非常に尖った突起状のマスクはその下部にできる突起状のダイヤモンドを形成するよいマスクとなる。しかも、突起角度が低い場合でも、選択比の調節によってダイヤモンドの突起の角度を制御できることは重要である。

#### 【0023】

微細に加工された突起をマスクとしてダイヤモンドをCF<sub>4</sub>を微量に添加した酸素ガス中でエッティングして、マスクサイズで先端がマスクサイズよりも微小なサイズの突起を形成した（図2（b）参照）。できたダイヤモンドの突起は先端が細くなったアスペクト比の2以上の背の高い突起である。突起先端中央の中心部分の精度は非常によく高さの精度もよいダイヤモンド突起が形成できる。

#### 【0024】

本ダイヤモンド突起はマスクのサイズに依存するので、μmサイズのものも作製可能である。しかしながら、300nm以下のサイズの突起を形成することできることが重要である。それは以下の理由による。

#### 【0025】

1 μmサイズの大きさのマスクを削って、先端が100nm以下のものを形成することを考えると、マスクが削られる際に徐々に精度が落ちてくる。エッティング精度を10%以上の精度でも先端径と同じ程度の誤差を生じてしまう。5%以上の誤差精度にするためには、0.5%以上のエッティング精度が必要である。これは現実的には困難である。

#### 【0026】

一方、マスクサイズが300nm以下のサイズであれば、エッティング誤差が10%でも100nmの先端を形成するのに30%の誤差ですみ、エッティング誤差を1%にすれば、3%の誤差を実現する。これなら実現可能である。従って、本エミッタはマスクの効果は300nm以下のものとなる。

#### 【0027】

このような突起型マスクを使って、ダイヤモンドをエッティングすると、非常に細い先端のとがった突起が形成でき、しかも、全体の幅のサイズが300nmよりも小さいにもかかわらず、非常に位置精度もよく形成できることがわかった。

#### 【0028】

突起マスクのアスペクト比（高さ／直径）はエッティング選択比と関係しているので、低くとも利用できる。できたダイヤモンドの突起がアスペクト比が2以上であることがほしい。

#### 【0029】

実際に微小なサイズの突起を形成すると、マスクの直径を150nmにし、ダイヤモンドの突起を形成すると、太さ150nmの先端径10nm以下の突起を形成することができた。このような微小突起は1 μm角に4個の突起を形成することができた。

#### 【0030】

本方法ではダイヤモンドと突起材料の選択比が大きく取れるので、非常にアスペクト比の高い突起を形成することができた。先端にマスクが残るようにエッティングをやめても、マスクサイズ自体が100nm以下と非常に小さいものを形成できる技術であるので、先端はおのずとマスクサイズ以下となり、非常に小さい先端を形成でき、高さバラツキも基板の表面粗さ程度に小さくすることができる。

#### 【0031】

次に、エミッタ密度に関して高密度化が重要である理由について以下に述べる。1 μm径の突起を形成したとき、エミッタ高さは少なくとも2 μm以上となり、エミッタ密度は

突起間隔も勘案して、せいぜい 250,000 個/mm<sup>2</sup> である。これは 1 本から安定して出せる電流を 0.1 μA として、25 mA/mm<sup>2</sup> となる。熱陰極材料を含む従来材料での放出電流密度は 100 mA/mm<sup>2</sup> 程度であったことを考えると少し足りないものである。

### 【0032】

しかし、300 nm 径以下の突起を形成すると、突起間隔は 500 nm とでき、エミッタ密度は 1,000,000 個/mm<sup>2</sup> 以上まであげられる。そうすると、電流密度は 100 mA/mm<sup>2</sup> 以上にもなり、従来材料以上のものを形成することができるようになる。従って、1 μm 角内に 4 本以上のエミッタを形成することはこれを境に有意義なデバイスを形成できることになる。これまででは、そのような密度のエミッタを形成する方法は提案されていなかった。さらに、200 nm 径以下であるなら、1 μm 角内に 6.25 本以上となり、明らかに有効である。

### 【0033】

ここで、ダイヤエミッタはアスペクト比の高い突起で、規則性をもって配列しているものをさしている。なぜなら、アスペクト比 1 以下の低いものはゲート電極を有する構造とした場合と基板と間で大きな容量を発生し、高周波動作の妨げとなる。また、セルフアライインでゲートを作製する場合も、背が低いとエミッタ周辺に穴を開けることが困難となるからである。また、ランダムな物も好ましくない。なぜならランダムなものは電流値の局部集中が防げず（電流に均一分散が設計できない）、大電流を出そうとする場合には、あまり意味を成さないからである。

### 【0034】

以上のような、エミッタを形成するためには本発明のマスクを用いてダイヤモンドを酸素を含むドライエッチングで加工することによって得ることができる。

### 【0035】

微細突起を実現するためには基板の平坦性は非常に良好なものである必要がある。成長したままの多結晶ダイヤモンドでは到底所望のものは得ることができない。100 nm より小さい平坦性が必要であることは形成しようとする突起のサイズ 1 μm から容易に類推でき、200 nm サイズの突起も形成可能であるので、好ましくは 20 nm より小さい平坦性が必要である。数 nm の基板平坦度を実現することは可能であるので、この基板を使うことは有益である。このような平坦性を有する基板は単結晶である方が形成しやすいが、多結晶であってもかまわない。

### 【0036】

さらに、突起自体はキャリアが消滅せずに先端まで到達する必要があることから、単独の単結晶であることが好ましい。これまでのサイズの突起では多結晶よりも、単結晶の方が好ましいのは突起中に粒界が含まれるためであるが、本発明の突起は非常に小さいものであるために、多結晶であってもかまわない。ただし、突起のサイズよりも大きな粒径の多結晶であることが好ましいのは前記の理由による。同じ理由で単結晶以外にも高配向の多結晶ダイヤモンドはランダムな配向の多結晶より好ましいし、ヘテロエピタキシャル基板はさらにより好ましい。

### 【0037】

以上の説明はダイヤモンド基板でなくとも、非常に高い平坦性（100 nm 以上、好ましくは 20 nm 以上の平坦性）を有する炭素系材料、例えば、DLC、a-CN 膜、a-C 膜、CNT/SiC、グラファイト/SiC に適用できる。

## 【実施例1】

### 【0038】

研磨によって数 nm 以下に平坦化した高圧合成単結晶ダイヤモンド基板（100）および CVD 多結晶ダイヤモンドウェハー基板を用意し、電子線リソ用レジスト塗布を行い、電子線露光を行い、逆テーパー型の穴を形成した（図 1（a）参照）。その上に Au、Mo、Pt および Al を蒸着し、その後レジストを除去し、金属をリフトオフした（図 1（c）参照）。これをマスクとして、ダイヤモンドをエッチングすると、図 3（a）、図 3

(b) に示すような非常に鋭角なダイヤモンドができた。図3(a)の突起は円錐台マスクによって形成されたもの。あるいは円錐マスクによって形成し、マスク材料がなくないうちにストップした形状である。図3(b)の突起は円錐マスクの最後までエッチングし、尖らせた形状である。非常に微細な尖銳突起を形成できた。材料の違いによって、突起の角度が異なるが、ほぼ同様な形状が形成できた。メタルとできた形状については図4にまとめた。

#### 【0039】

マスクの突起は同じような形状のものができたので、ダイヤモンド突起も精度のバラツキが少ないものができた。マスクが残っているまま途中でエッチング止めると、先端径は大きいが、高さバラツキの非常に少ない（基板のラフネスに対応する程度の）突起を形成することができた。

#### 【0040】

単結晶基板、多結晶ウェハー基板での突起の違いはなかった。エッチングされた表面が単結晶基板の方が平坦であったぐらいである。

#### 【実施例2】

##### 【0041】

研磨によって数nm以下に平坦化した高圧合成単結晶ダイヤモンド基板(100)、CVD多結晶ダイヤモンドウェハー基板およびSiC基板を用意し、それらの基板に不活性ガス、窒素をイオン注入を行ったもの、その試料を真空中で高温アニール(1500°C、1800°C)で処理したもの、イオン注入を行わない試料を高温中で処理したもの用意した。これらの表面にはグラファイトと思われる導電性の黒い層が形成できた。これらの試料上に実施例1と同じ方法で突起形状マスクを形成した。これをマスクとして、炭素系材料をエッチングすると、図3(a)、図3(b)に示すような非常に鋭角な炭素系材料の突起ができた。エッチングによって表面の炭素系材料が除去されたので、再度同じ方法で、導電性の炭素系材料を形成した。一部にはメタル(A1)を被覆して形成した。得られた試料と電子放出特性について図5にまとめた。図5にあるように測定結果より導電性の炭素系材料の突起があるものとないもので、明らかに電子放出特性に効果が現れ、突起の形成が重要であることがわかった。尚、図5においては、(A)～(G)が、導電性炭素系材料形成、突起形成、導電性炭素系材料形成としたもの、(H)が、導電性炭素系材料形成、突起形成、A1被覆(先端露出)としたものを示している。また、電極間隔は100μmである。

#### 【実施例3】

##### 【0042】

研磨によって数nm以下に平坦化した高圧合成単結晶ダイヤモンド基板(100)およびCVD多結晶ダイヤモンドウェハー基板を用意し、電子線リソ用レジスト塗布を行い、電子線露光を行い、逆テーパー型の穴を形成した(図1(a)参照)。その上にSiO<sub>2</sub>を原料としてEB蒸着法でSiO<sub>x</sub>膜を蒸着し、その後レジストを除去し、SiO<sub>x</sub>膜をリフトオフした(図1(c)参照)。SiO<sub>x</sub>膜は酸素ガスを微量導入した場合は、SiO<sub>2</sub>膜に近いものが得られたが、不活性ガス中、あるいは高真空中では酸素の少ない膜となった。組成は図6の通りである。これをマスクとして、ダイヤモンドをエッチングすると、非常に鋭角なダイヤモンドができた。実施例1のように金属マスクでなくとも、ダイヤモンド突起のできることができることが確認できた。xの組成によって突起のアスペクト比や角度を制御することがわかった。この結果を図6にまとめた。やはりこのマスクも単結晶基板、多結晶ウェハー基板での突起の違いはなかった。

#### 【図面の簡単な説明】

##### 【0043】

【図1】本実施形態の微小突起マスクの形成方法を説明する図である。

【図2】本実施形態の微小突起マスクの形成方法を説明する図である。

【図3】本実施形態の微小突起マスクにより形成した突起を説明する図である。

【図4】形成された突起を説明する図である。

【図5】形成された突起と特性を説明する図である。

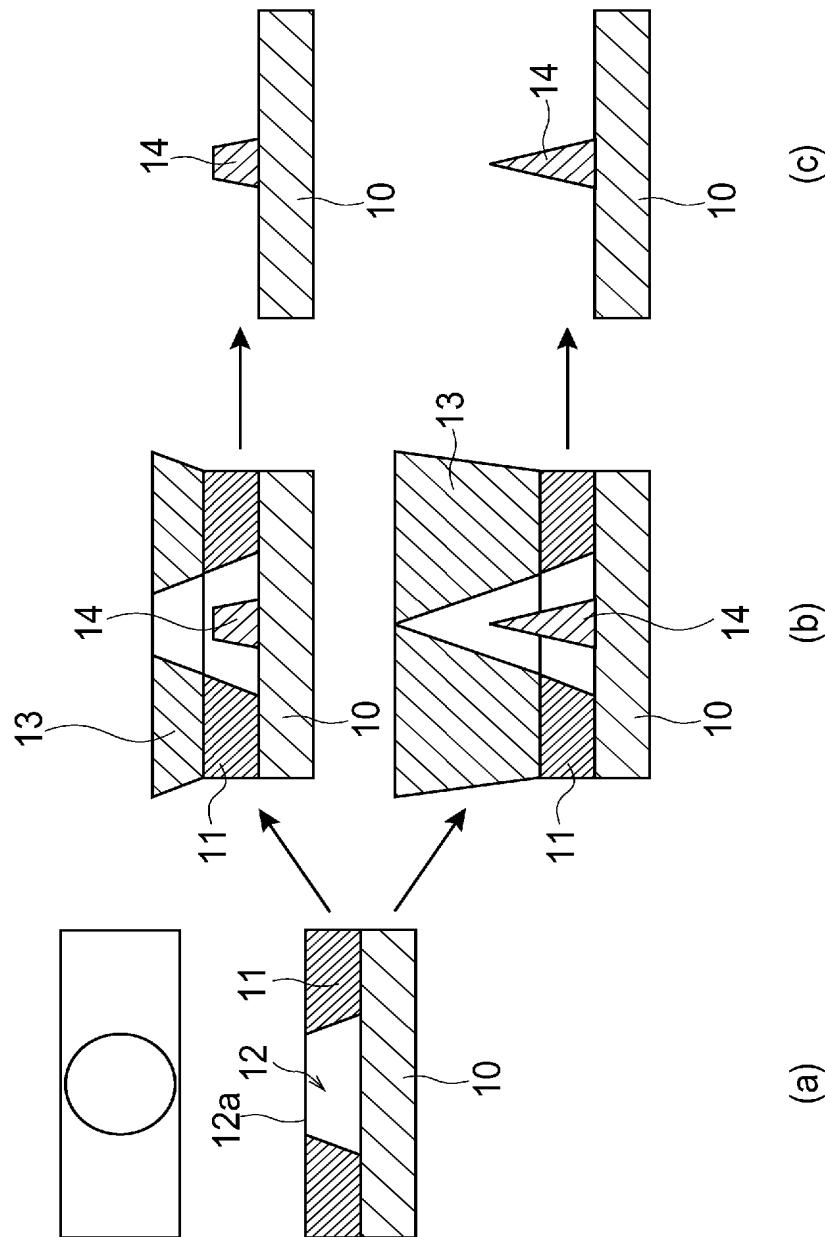
【図6】形成された突起を説明する図である。

【符号の説明】

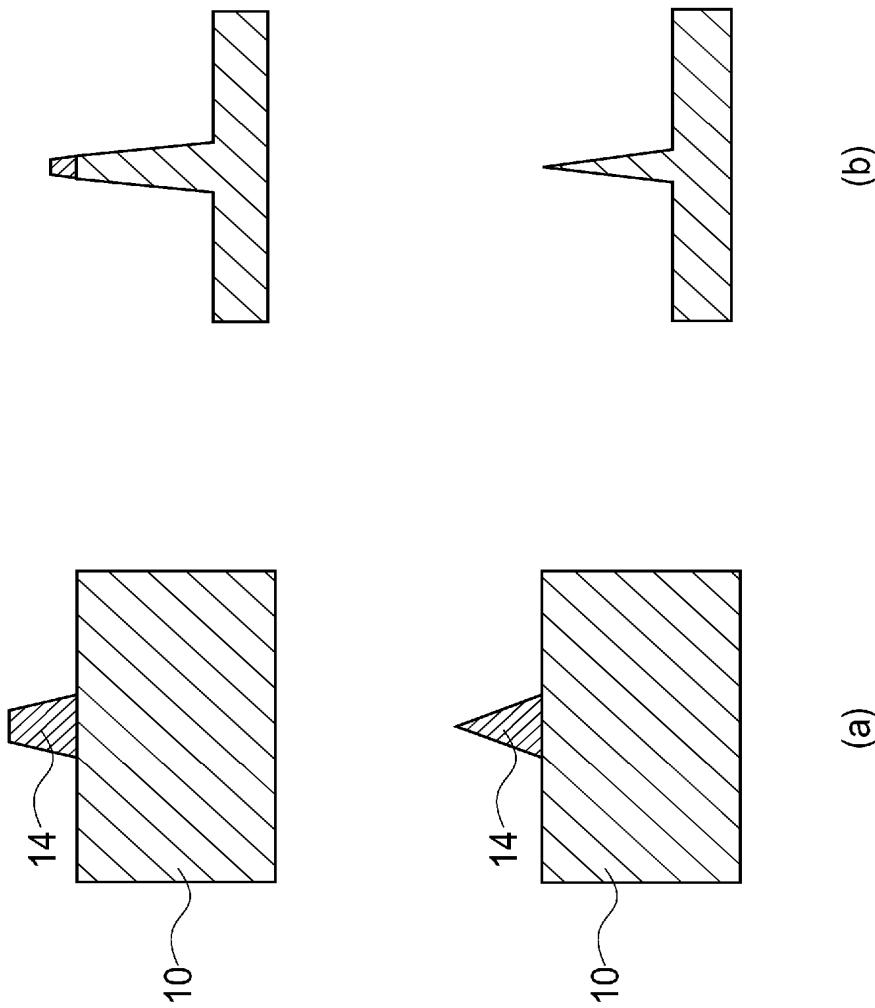
【0 0 4 4】

1 0 … ダイヤモンド基板、1 1 … レジスト、1 2 … 穴、1 3 … 金属、1 4 … 蒸着物。

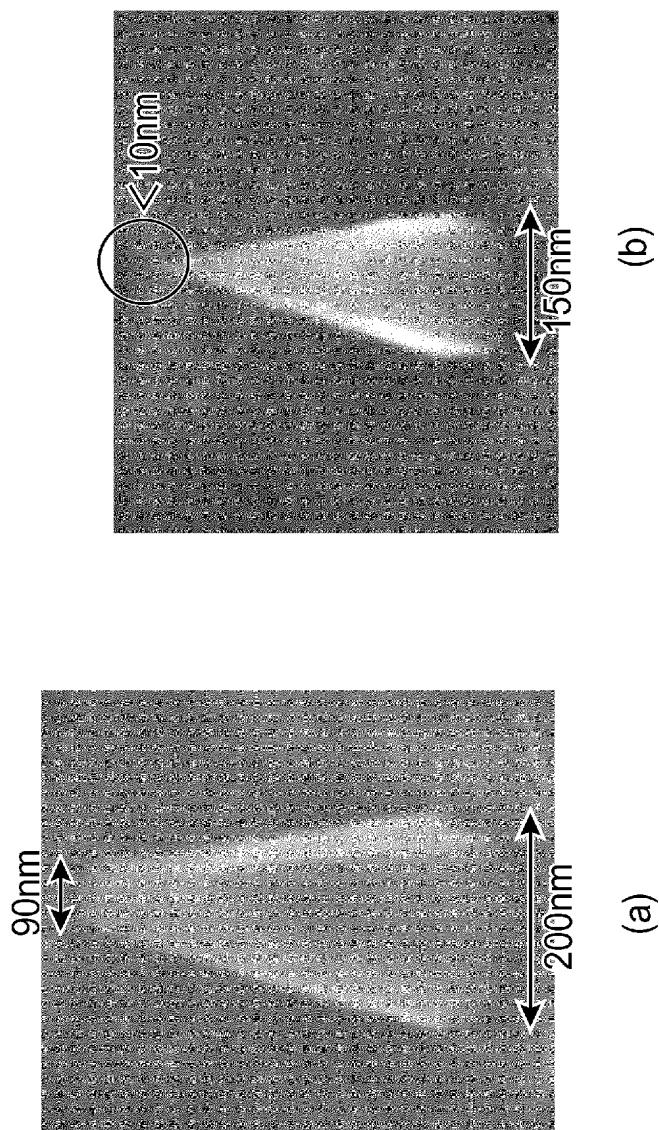
【書類名】 図面  
【図 1】



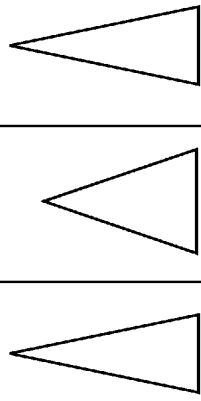
【図 2】



【図 3】



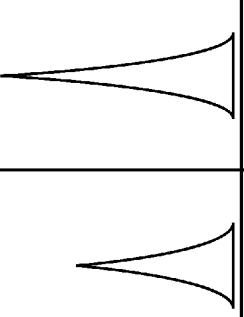
【図 4】

	Au	Mo	Pt	Al
突起形状				
先端突起角度(度)	30	40	15	10
アスペクト比	4	2.5	4	5

【図 5】

	試料の形成方法	平板試料のしきい値電圧	突起試料のしきい値電圧
(A)	ダイヤモンドへNイオン注入(150keV、 $10^{15} \text{ cm}^{-2}$ )試料	>3kV	1000V
(B)	ダイヤモンドへArイオン注入(150keV: $10^{15} \text{ cm}^{-2}$ )試料	>3kV	1100V
(C)	ダイヤモンドへArイオン注入(150keV: $10^{15} \text{ cm}^{-2}$ )後、 真空アニール1500°Cの試料	>3kV	800V
(D)	ダイヤモンドを真空アニール1500°Cの試料	>3kV	1000V
(E)	ダイヤモンドを真空アニール1800°Cの試料	>3kV	900V
(F)	Sinを1800°Cの真空アニール試料	>3kV	1000V
(G)	SiCへArイオン注入(150keV: $10^{15} \text{ cm}^{-2}$ )後、 1800°Cの真空アニール試料	>3kV	900V
(H)	ダイヤモンドへArイオン注入(150keV: $10^{15} \text{ cm}^{-2}$ )後、 真空アニール1500°Cの試料	>3kV	800V

【図 6】

	SiO <sub>x</sub> $X=1.5$	SiO <sub>x</sub> $X=1.9$
ダイヤ突起形状		
先端突起角度(度)	20	10
アスペクト比	2.0	4

【書類名】要約書

【要約】

【課題】 微小な精度良い微細マスクを形成できる炭素系材料突起の形成方法を提供すること。

【解決手段】 この炭素系材料突起の形成方法は、ダイヤモンド基板10上にレジスト11を塗布する工程と、当該塗布したレジスト11に所定の配置規則に従って穴12を開け、その穴12の壁12bは開口部12aから奥側に向かって逆テーパーになるように加工する工程と、開口部12a側からマスク材料を蒸着し、穴12の内部にマスク蒸着物14を形成する工程と、レジスト11上に蒸着されたマスク材料13をレジスト11と共にリフトオフする工程と、マスク蒸着物14をマスクとしてダイヤモンド基板10をエッチングし、炭素系材料突起を形成する工程と、を含む。

【選択図】 図1

出願人履歴

0 0 0 0 0 2 1 3 0

19900829

新規登録

大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号  
住友電気工業株式会社